MENU SEARCH INDEX DETAIL

1/1



#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11295560

(43)Date of publication of application: 29.10.1999

(51)Int.CI.

G02B 6/42 H01L 31/12 H01S 3/18 H04B 10/08

(21)Application number: 10097512

(22)Date of filing: 09.04.1998

(71)Applicant:

(72)Inventor:

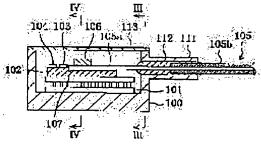
MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

NISHIKAWA TORU MITSUTA MASAHIRO UNO TOMOAKI MATSUDA KENICHI

(54) MODULE FOR OPTICAL COMMUNICATION AND INSPECTION METHOD THEREFOR

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To control the temperature of a semiconductor laser element from the outside of a package, to lower the price of a module for optical communication and to miniaturize it. SOLUTION: A Peltier element 101 is provided on the bottom part of the package 100 and a base 102 is fixed on the Peltier element 101. On the base 102, the semiconductor laser element 103 and a photodetector 104 for monitoring are fixed. A recessed groove whose cross section is chevron-shaped is formed on the upper surface of the base 102 so as to be extended in an optical axis direction and the incident part 105a of an optical fiber 105 is fitted to the recessed groove. A fiber pressing member 106 provided with the recessed groove whose cross section is trapezoidal is fixed on the upper side of the base 102 and the incident part 105a of the optical fiber 105 is clamped by the base 102 and the fiber pressing member 106. A notched part 107 extended in a direction perpendicular to an optical axis is formed at the base 102 and the left end face of the optical fiber 105 is abutted on the wall surface on the side of the semiconductor laser element 103 of the notched part 107.



**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office



#### (19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平11-295560

(43)公開日 平成11年(1999)10月29日

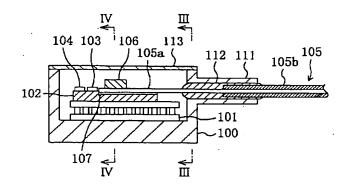
| (51) Int.Cl. 6 | 識別記号             | ΡΙ                           |
|----------------|------------------|------------------------------|
| G02B 6/42      |                  | G 0 2 B 6/42                 |
| H01L 31/12     |                  | H 0 1 L 31/12 H              |
| H01S 3/18      |                  | H 0 1 S 3/18                 |
| H 0 4 B 10/08  |                  | H 0 4 B 9/00 K               |
|                |                  | 審査請求 未請求 請求項の数17 〇L (全 13 頁) |
| (21)出願番号       | 特願平10-97512      | (71) 出願人 000005821           |
|                | · ·              | 松下電器産業株式会社                   |
| (22)出願日        | 平成10年(1998) 4月9日 | 大阪府門真市大字門真1006番地             |
|                |                  | (72)発明者 西川 透                 |
|                |                  | 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器        |
|                |                  | 産業株式会社内                      |
|                |                  | (72)発明者 光田 昌弘                |
|                |                  | 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器        |
|                |                  | 産業株式会社内                      |
|                |                  | (72)発明者 宇野 智昭                |
|                |                  | 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器        |
|                |                  | 産業株式会社内                      |
|                |                  | (74)代理人 弁理士 前田 弘 (外2名)       |
|                |                  | 最終頁に続く                       |

#### (54) 【発明の名称】 光通信用モジュール及びその検査方法

#### (57)【要約】

【課題】 半導体レーザ素子の温度をパッケージの外部 から制御できると共に、光通信用モジュールの低価格化 及び小型化を実現できるようにする。

【解決手段】 パッケージ100の底部にはペルチェ素 子101が設けられ、ペルチェ素子101の上にはベー ス102が固定されている。ベース102の上には半導 体レーザ素子103及びモニター用受光素子104が固 定されている。ベース102の上面には断面V字状の凹 状構が光軸方向に延びるように形成され、該凹状構には 光ファイバ105の入射部105aが嵌め込まれてい る。ベース102の上側には、断面台形状の凹状溝を有 するファイバ押さえ部材106が固定されており、光フ ァイバ105の入射部105aはベース102とファイ バ押さえ部材106とにより狭持されている。ベース1 02には光軸と垂直な方向に延びる切欠き部107が形 成されており、切欠き部107の半導体レーザ素子10 3側の壁面に光ファイバ105の左端面が当接してい る。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 内部が気密に保持されるパッケージと、 前記パッケージの底部に固定され、外部から温度制御される冷却手段と、

前記冷却手段の上に固定されたベースと、

前記ベースの上に固定され、レーザ光を出射する半導体 レーザ素子と、

前記ベースの上に固定され、前記半導体レーザ素子から 出射されたレーザ光の光出力を検出するモニター用受光 素子と、

前記ベースの上に固定され、一端部に前記半導体レーザ素子から出射されたレーザ光が入射され、他端部から出力信号光を出力する光ファイバとを備えていることを特徴とする光通信用モジュール。

【請求項2】 前記ベースに設けられ、前記光ファイバの他端部から入力された後、前記光ファイバ内を伝搬する入力信号光を上方へ導く光分岐器と、

前記ベースの上に固定され、前記光分岐器により上方へ 導かれた入力信号光を受ける受信用受光素子とをさらに 備えていることを特徴とする請求項1に記載の光通信用 モジュール。

【請求項3】 前記ベースに設けられ、前記光ファイバ内を伝搬する入力信号光が前記半導体レーザ素子に進入することを阻止するインライン型の光アイソレータをさらに備えていることを特徴とする請求項2に記載の光通信用モジュール。

【請求項4】 前記ベースに設けられ、前記光ファイバの前記半導体レーザ素子に対する位置を規制する光ファイバ位置決め手段をさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載の光通信用モジュール。

【請求項5】 前記光ファイバ位置決め手段は、

前記ベースに光軸方向へ延びるように形成され、前記光 ファイバが嵌合されることにより前記光ファイバの光軸 と垂直な方向の位置を規制する凹状溝と、

前記ベースに光軸と垂直な方向へ延びるように形成され、前記半導体レーザ素子側の壁面に前記光ファイバの 一端部が当接することにより前記光ファイバの光軸方向 の位置を規制する切り込み溝とを有している請求項4に 記載の光通信用モジュール。

【請求項6】 前記冷却手段に設けられ、前記ベースの前記冷却手段に対する位置を規制するベース位置決め手段をさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載の光通信用モジュール。

【請求項7】 前記ベース位置決め手段は、前記冷却手段の上面に形成され、前記ベースが嵌合可能な形状を有する凹部であることをことを特徴とする請求項6に記載の光通信用モジュール。

【請求項8】 前記ベース位置決め手段は、前記冷却手段の上面に形成されたアライメントマークであることを特徴とする請求項6に記載の光通信用モジュール。

【請求項9】 前記冷却手段はペルチェ素子であることを特徴とする請求項1に記載の光通信用モジュール。

【請求項10】 前記半導体レーザ素子は、分布帰還型のレーザ素子、ポンプレーザ、狭放射角レーザ素子又はスポットサイズ変換レーザ素子であることを特徴とする請求項1に記載の光通信用レーザ素子。

【請求項11】 前記光ファイバは、前記半導体レーザ素子のスポット径とほぼ等しいコア径を有する単一モードの光ファイバであることを特徴とする請求項1に記載の光通信用モジュール。

【請求項12】 前記半導体レーザ素子は前記ベースに、鉛を有しない鉛フリー半田によって固定されていることを特徴とする請求項1に記載の光通信用モジュール。

【請求項13】 前記ベースは前記冷却手段に、鉛を 有しない熱伝導性ペーストによって固定されていること を特徴とする請求項1に記載の光通信用モジュール。

【請求項14】 前記ベースの下面には金属蒸着層が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の光通信用モジュール。

【請求項15】 前記ベースの上面に形成されており、前記ベースの上面に形成され前記半導体レーザ素子の下部電極と直接に接続された第1の外部電極と電気的に接続されている第1の検査用電極と、

前記ベースの上面に形成されており、前記ベースの上面 に形成され前記半導体レーザ素子の上部電極とボンディ ングワイヤにより接続された第2の外部電極と電気的に 接続されている第2の検査用電極と、

前記ベースの上面に形成されており、前記ベースの上面 に形成され前記モニター用受光素子の下部電極と直接に 接続された第3の外部電極と電気的に接続されている第 3の検査用電極と、

前記ベースの上面に形成されており、前記ベースの上面 に形成され前記モニター用受光素子の上部電極とボンディングワイヤにより接続された第4の外部電極と電気的 に接続されている第4の検査用電極とをさらに備えてい ることを特徴とする請求項1に記載の光通信用モジュール。

【請求項16】 ベースの上に固定され、レーザ光を出射する半導体レーザ素子と、前記ベースの上に固定され、前記半導体レーザ素子から出射されたレーザ光の光出力を検出するモニター用受光素子と、前記ベースの上に固定され、一端部に前記半導体レーザ素子から出射されたレーザ光が入射され、他端部から出力信号光を出力する光ファイバと、前記ベースの上面に形成され、前記半導体レーザ素子の下部電極と電気的に接続された第1の検査用電極と、前記ベースの上に形成され、前記モニター用受光素子の下部電極と電気的に接続された第3の検

査用電極と、前記モニター用受光素子の上部電極と電気 的に接続された第4の検査用電極とを有する光通信用モ ジュールの検査方法であって、

前記第1の検査用電極に第1のプローブ針を接触させる と共に前記第2の検査用電極に第2のプローブ針を接触 させ、前記第1のプローブ針と前記第2のプローブ針と の間に検査用電流を印加する電流印加工程と、

前記第3の検査用電極に第3のプローブ針を接触させる と共に前記第4の検査用電極に第4のプローブ針を接触 させ、前記第3のプローブ針と前記第4のプローブ針と の間に流れる電流を検出する電流検出工程と、

前記電流検出工程において検出された電流に基づき、前 記半導体レーザ素子の電気特性を検査する検査工程とを 備えていることを特徴とする光通信用モジュールの検査 方法。

【請求項17】 前記第1の検査用電極は、前記ベースの上に形成され前記半導体レーザ素子の下部電極と直接に接続された第1の外部電極と電気的に接続されており、前記第2の検査用電極は、前記ベースの上に形成され前記半導体レーザ素子の上部電極とボンディングワイヤにより接続された第2の外部電極と電気的に接続されており、前記第3の検査用電極は、前記ベースの上に形成され前記モニター用受光素子の下部電極と直接に接続された第3の外部電極と電気的に接続されており、前記第4の検査用電極は、前記ベースの上に形成され前記モニター用受光素子の上部電極とボンディングワイヤにより接続された第4の外部電極とボンディングワイヤにより接続された第4の外部電極と電気的に接続されていることを特徴とする請求項16に記載の光通信用モジュールの検査方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】光信号を光ファイバで双方向 に伝送する光伝送システムに使用される光通信用モジュ ール及びその検査方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、センター局からデータや多チャンネルの映像情報等の光信号を加入者である一般家庭又はその付近(電柱又は数戸の住宅の間)まで光ファイバを用いて伝送する光加入者システムが提案され、検討されている。この光加入者システムに用いられる光通信用モジュールは屋内だけでなく電柱等の屋外でも使用されると考えられる。従って、屋内と比較して厳しい屋外の温度条件下でも、光通信用モジュールを安定して動作させる必要がある。光通信用モジュールの光出力特性は温度依存性が大きいので、環境温度に関係なく安定した光出力特性を得るためには、光通信用モジュールの温度を一定に保つ必要がある。

【0003】従って、光加入者システムに用いられる光 通信用モジュールにおいては、レーザ光を出射する半導 体レーザ素子の温度をパッケージの外部から制御できる ことが好ましい。

【0004】そこで、光加入者システムに用いられる光 通信用モジュールとして、特開平9-21929号に記 載され、図11に示す構造のものが提案されている。

【0005】以下、従来の光通信用モジュールについて 図11を参照しながら説明する。

【0006】パッケージ10の底部にはペルチェ素子11が設けられており、該ペルチェ素子11の上には金属製のレンズマウント12が載置されている。レンズマウント12の上における中央部にはレーザマウント13が固定され、該レーザマウント13は半導体レーザ素子14を保持している。レンズマウント12におけるレーザマウント13の右側には、半導体レーザ素子14から出射されるレーザ光を集光する非球面レンズ15が設けられている。

【0007】パッケージ10の出射部10aには光アイソレータ16が設けられていると共に、パッケージ10の出射部10aにおける光アイソレータ16の内側には気密用ガラス板17が固定されている。また、パッケージ10の出射部10aには円筒状のファイバ固定部材18が固定され、該ファイバ固定部材18は光ファイバ19の一端に固定されたフェルール20を保持している。

【0008】レンズマウント12の上におけるレーザマウント13の左側にはモニターマウント21が固定され、該モニターマウント21は、半導体レーザ素子14から出射されるレーザ光をモニターするモニター用受光素子22を保持している。また、レーザマウント12の上におけるモニターマウント21の左側には、レンズマウント12の温度を検出する温度検出器23が設けられている。

【0009】パッケージ10は前述した各部材が収納された状態でキャップ24によって気密封止される。この場合、パッケージ10の内部を長期間に亘って気密状態に保つためにパッケージ10とキャップ24とは溶接されていると共に、気密用ガラス17の周囲には金属膜が形成され、該金属膜とパッケージ10とは半田により固定されている。また、光アイソレータ16とパッケージ10の出射部10aとの間も気密封止されている。

【0010】前記従来の光通信用モジュールにおいては、半導体レーザ素子14から出射されたレーザ光は非球面レンズ15により光ファイバ19の一端部に結合した後、光ファイバ19を伝搬して該光ファイバ19の他端部から出力信号光として出力される。

【0011】また、半導体レーザ素子14から出射されるレーザ光の光出力をモニター用受光素子22によりモニターすることによって、半導体レーザ素子14の光出力が制御されると共に、レンズマウント12の温度は温度検出器23及びペルチェ素子11によって制御される

[0012]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前述したように、光加入者システムに用いられる光通信用モジュールにおいては、レーザ光を出射する半導体レーザ素子の温度をパッケージの外部から制御できることが好ましいと共に、光加入者システムの普及に伴って、光通信用モジュールの低価格化及び小型化が望まれる。

【0013】ところが、前記従来の光通信用モジュールにおいては、部品点数が多いので、低価格化及び小型化が制約されるという問題がある。

【0014】前記に鑑み、本発明は、半導体レーザ素子の温度をパッケージの外部から制御できると共に、光通信用モジュールの低価格化及び小型化を実現できるようにすることを目的とする。

#### [0015]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するため、本発明に係る光通信用モジュールは、内部が気密に保持されるパッケージと、パッケージの底部に固定され、外部から温度制御される冷却手段と、冷却手段の上に固定されたベースと、ベースの上に固定され、レーザ光を出射する半導体レーザ素子と、ベースの上に固定され、半導体レーザ素子から出射されたレーザ光の光出力を検出するモニター用受光素子と、ベースの上に固定され、一端部に半導体レーザ素子から出射されたレーザ光が入射され、他端部から出力信号光を出力する光ファイバとを備えている。

【0016】本発明の光通信用モジュールによると、冷却手段の上に固定されたベースの上に半導体レーザ素子が直接に固定されているため、半導体レーザ素子に発生した熱はベースを介して冷却手段に直接に伝わると共にベースと半導体レーザ素子との間に半導体レーザ素子を保持するレーザマウントが不要になる。また、半導体レーザ素子から出射されたレーザ光は光ファイバに直接に入射するため、半導体レーザ素子から出射されたレーザ光を集光する集光レンズが不要になる。

【0017】本発明の光通信用モジュールは、ベースに設けられ、光ファイバの他端部から入力された後、光ファイバ内を伝搬する入力信号光を上方へ導く光分岐器と、ベースの上に固定され、光分岐器により上方へ導かれた入力信号光を受ける受信用受光素子とをさらに備えていることが好ましい。

【0018】本発明の光通信用モジュールは、ベースに設けられ、光ファイバ内を伝搬する入力信号光が半導体レーザ素子に進入することを阻止するインライン型の光アイソレータをさらに備えていることが好ましい。

【0019】本発明の光通信用モジュールは、ベースに設けられ、光ファイバの半導体レーザ素子に対する位置を規制する光ファイバ位置決め手段をさらに備えていることが好ましい。

【0020】この場合、光ファイバ位置決め手段は、ベースに光軸方向へ延びるように形成され、光ファイバが

嵌合されることにより光ファイバの光軸と垂直な方向の 位置を規制する凹状構と、ベースに光軸と垂直な方向へ 延びるように形成され、半導体レーザ素子側の壁面に光 ファイバの一端部が当接することにより光ファイバの光 軸方向の位置を規制する切り込み構とを有していること が好ましい。

【0021】本発明の光通信用モジュールは、冷却手段に設けられ、ベースの冷却手段に対する位置を規制するベース位置決め手段をさらに備えていることが好ましい。

【0022】この場合、ベース位置決め手段は、冷却手段の上面に形成され、ベースが嵌合可能な形状を有する 凹部であることが好ましい。

【0023】また、この場合、ベース位置決め手段は、 冷却手段の上面に形成されたアライメントマークである ことが好ましい。

【0024】本発明の光通信用モジュールにおいて、冷却手段はペルチェ素子であることが好ましい。

【0025】本発明の光通信用モジュールにおいて、半 導体レーザ素子は、分布帰還型のレーザ素子、ポンプレ ーザ、狭放射角レーザ素子又はスポットサイズ変換レー ザ素子であることが好ましい。

【0026】本発明の光通信用レーザ素子において、光ファイバは、半導体レーザ素子のスポット径とほぼ等しいコア径を有する単一モードの光ファイバであることが好ましい。

【0027】本発明の光通信用モジュールにおいて、半 導体レーザ素子はベースに、鉛を有しない鉛フリー半田 によって固定されていることが好ましい。

【0028】本発明の光通信用モジュールにおいて、ベースは冷却手段に、鉛を有しない熱伝導性ペーストによって固定されていることが好ましい。

【0029】本発明の光通信用モジュールにおいて、ベースの下面には金属蒸着層が形成されていることが好ましい。

【0030】本発明の光通信用モジュールは、ベースの上面に形成されており、ベースの上面に形成され半導体レーザ素子の下部電極と直接に接続された第1の外部電極と電気的に接続されている第1の検査用電極と、ベースの上面に形成されており、ベースの上面に形成され半導体レーザ素子の上部電極とボンディングワイヤにより接続された第2の外部電極と電気的に接続されている第2の検査用電極と、ベースの上面に形成されており、ベースの上面に形成されモニター用受光素子の下部電極と直接に接続された第3の外部電極と電気的に接続されている第3の検査用電極と、ベースの上面に形成されており、ベースの上面に形成されモニター用受光素子の上部電極とボンディングワイヤにより接続された第4の外部電極とボンディングワイヤにより接続された第4の外部電極と電気的に接続されている第4の検査用電極とをさらに備えていることが好ましい。

【0031】本発明に係る光通信用モジュールの検査方 法は、ベースの上に固定され、レーザ光を出射する半導 体レーザ素子と、ベースの上に固定され、半導体レーザ 素子から出射されたレーザ光の光出力を検出するモニタ 一用受光素子と、ベースの上に固定され、一端部に半導 体レーザ素子から出射されたレーザ光が入射され、他端 部から出力信号光を出力する光ファイバと、ベースの上 面に形成され、半導体レーザ素子の下部電極と電気的に 接続された第1の検査用電極と、ベースの上に形成さ れ、半導体レーザ素子の上部電極と電気的に接続された 第2の検査用電極と、ベースの上面に形成され、モニタ 一用受光素子の下部電極と電気的に接続された第3の検 査用電極と、モニター用受光素子の上部電極と電気的に 接続された第4の検査用電極とを有する光通信用モジュ ールの検査方法であって、第1の検査用電極に第1のプ ローブ針を接触させると共に第2の検査用電極に第2の プローブ針を接触させ、第1のプローブ針と第2のプロ ーブ針との間に検査用電流を印加する電流印加工程と、 第3の検査用電極に第3のプローブ針を接触させると共 に第4の検査用電極に第4のプローブ針を接触させ、第 3のプローブ針と第4のプローブ針との間に流れる電流 を検出する電流検出工程と、電流検出工程において検出 された電流に基づき、半導体レーザ素子の電気特性を検 査する検査工程とを備えている。

【0032】本発明の光通信用モジュールの検査方法によると、第1のプローブ針と第2のプローブ針との間に検査用電流を印加することにより、第1の検査用電極と第2の検査用電極との間ひいては半導体レーザ素子の下部電極と上部電極との間に検査用電流を印加することができると共に、第3のプローブ端子と第4のプローブ端子との間の電流を検出することにより、第3の検査用電極と第4の検査用電極との間に流れる電流ひいてはモニター用受光素子の下部電極と上部電極との間に流れる電流を検出することができる。

【0033】本発明の光通信用モジュールの検査方法において、第1の検査用電極は、ベースの上に形成され半導体レーザ素子の下部電極と直接に接続された第1の外部電極と電気的に接続されており、第2の検査用電極は、ベースの上に形成され半導体レーザ素子の上部電極とボンディングワイヤにより接続された第2の外部電極と電気的に接続されており、第3の検査用電極は、ベースの上に形成されモニター用受光素子の下部電極と直接に接続された第3の外部電極と電気的に接続されており、第4の検査用電極は、ベースの上に形成されモニター用受光素子の上部電極とボンディングワイヤにより接続された第4の外部電極と電気的に接続されていることが好ましい。

#### [0034]

【発明の実施の形態】 (第1の実施形態) 以下、本発明の第1の実施形態に係る光通信用モジュールについて図

1~図4を参照しながら説明する。図1は光通信用モジュールの側方断面図、図2はキャップを取り除いた状態の光通信用モジュールの平面図、図3は図1におけるIII-III 線の断面図、図4は図1におけるVI-VI線の断面図である。

【0035】パッケージ100の底部には冷却手段としてのペルチェ素子101が設けられており、該ペルチェ素子101の上には方形板状のベース102が固定されている。ベース102をペルチェ素子101に固定する方法としては、半田付け又は樹脂等の接着剤が挙げられが、鉛が含まれていない鉛フリー半田又は鉛フリーペーストを用いると、人体に対する悪影響を防止できる。

【0036】また、ベース102をペルチェ素子101 に熱伝導性ペーストによって固定したり、ベース102 の下面に金属蒸着層を形成したりすると、ベース102 とペルチェ素子101との間の熱伝導性を向上させるこ とができる。

【0037】ベース102の上における図1及び図2の左側には、例えば波長 $1.3\mu$ m帯のレーザ光を出射する半導体レーザ素子103と、該半導体レーザ素子103から出射されるレーザ光の強度をモニターするフォトダイオードからなるモニター用受光素子104とが画像認識により高精度に搭載されている。

【0038】ベース102の上面における半導体レーザ素子103が搭載されている部分よりも右側には、図4に示すように、断面V字状の凹状溝が光軸方向に延びるように形成されており、該凹状溝には単一モードの光ファイバ105の入射部105aが嵌め込まれている。

【0039】ベース102の中央部の上側には、断面台形状の凹状溝を有するファイバ押さえ部材106が固定されており、光ファイバ105の入射部105aは、ベース102の凹状溝の両壁面とファイバ押さえ部材106の底面との3点によって狭持されている。

【0040】ベース102における半導体レーザ素子103が搭載されている部分の右側には、光軸と垂直な方向に延びる切欠き部107が形成されている。切欠き部107の半導体レーザ素子103側の壁面に光ファイバ105の左端面(入射端面)が当接しており、これによって、半導体レーザ素子103と光ファイバ105の左端面(入射端面)との距離が規制されている。

【0041】光ファイバ105の入射部105aが3点によって狭持されていること及び光ファイバ105の入射端面が切欠き部107の壁面に当接していることによって、パッシブアライメント方式でサブミクロンオーダーの光軸調整が可能になっている。

【0042】ベース102の上面における切欠き部107よりも左側には、半導体レーザ素子103に電流を印加したり又はモニター用受光素子104に生じる電流を検出したりするための外部電極108が設けられており、該外部電極108は外部リード109とボンディン

グワイヤ110によって電気的に接続されている。また、ペルチェ素子101と外部リード109ともボンディングワイヤ110によって電気的に接続されている。

【0043】パッケージ100における右側の壁部には 光ファイバ105を保持するための筒状部111がパッケージ100と一体に設けられており、該筒状部111 に挿通されている光ファイバ105のジャケット部10 5bは筒状部111に固定用樹脂112によって固定されている。尚、パッケージ100の内部の気密性を向上させるためには、光ファイバ105のジャケット105 bの表面に金属層(図示は省略している。)を形成し、 該金属層と筒状部111とを半田によって固定することが好ましい。

【0044】モジュール100の内部に前述した各部材を搭載した後、モジュール100の上部開口部はキャップ113によって気密封止されている。キャップ113をモジュール100に固定する手段としては、溶接、半田付け又は樹脂等の接着剤が挙げられ、溶接、半田付け及び接着剤の順に、気密性は劣るがコスト的には有利になる。この場合、鉛が含まれていない鉛フリー半田又は鉛フリーペーストを用いると、人体に対する悪影響を防止できる。

【0045】ところで、ベース102の上に半導体レーザ素子103、モニター用受光素子104及び光ファイバ105を高精度に実装するために、ベース102の上には画像認識用のアライメントマーク(図示は省略している。)及び断面V字状の凹状溝を高精度に加工する必要がある。また、半導体レーザ素子103から発生する熱をベース102を介してペルチェ素子101に効率良く放散させる必要がある。

【0046】従って、ベース102を構成する材料としては、加工が容易で且つ熱伝導率の良いシリコンの単結晶が好ましい。シリコンの単結晶は、フォトリソグラフィー、異方性エッチング及び金属蒸着等の半導体プロセスを駆使して非常に高精度な形状に加工することができる。また、シリコンの単結晶は熱伝導性が良いため、半導体レーザ素子103のヒートシンクとしても十分な役割を果たすことができる。

【0047】半導体レーザ素子103としては、レーザ 光を光ファイバ105の入射端面に高い結合効率で結合 するために、狭放射角レーザ素子のようにスポットサイ ズが大きいものが好ましい。

【0048】通常のスポットサイズを持つ半導体レーザ素子103を用いる場合には、半導体レーザ素子103のスポットサイズと同程度のコア径を持つ光ファイバ105を使用して、レーザ光を光ファイバ105の入射部105aに直接に結合させることにより、高い結合効率を得ることができる。例えば、光ファイバ105のコア部の径と半導体レーザ素子103のスポットサイズとの差を約3.0μm以下にすると、80%程度の結合効率

が得られる。

【0049】また、半導体レーザ素子103としては、 光通信用モジュールが波長多重システムの光信号出力源 として用いられ単一波長で発振する必要がある場合に は、狭放射角機能を有するDFB(分布帰還型)レーザ 素子が好ましく、光通信用モジュールがファイバアンプ 等のように非常に高い出力が求められる場合には、長い 共振器長を有するポンプレーザ素子が好ましい。

【0050】モニター用受光素子104としては、導波路型又はエッチング面取ミラー型等の端面入射型のフォトダイオードを用いることが好ましい。

【0051】(第1の実施形態の第1変形例)ところで、パッケージ100の内部の気密性を向上させるためには、筒状部111と光ファイバ105のジャケット105bとの隙間は小さい方が好ましく、該隙間を小さくするためには、ベース102を高精度でペルチェ素子101に実装する必要がある。

【0052】そこで、第1の変形例においては、図5に示すように、ペルチェ素子101の上部にベース102が嵌合可能な大きさの位置決め用凹部120が設けられていると共に、位置決め用凹部120の底面に画像認識用のアライメントマーク121が形成されている。

【0053】尚、図示は省略したが、パッケージ100の底部にペルチェ素子101が嵌合可能な大きさの位置 決め用凹部を設けたり、画像認識用のアライメントマークを設けたりしてもよい。

【0054】このようにすると、ベース102のパッケージ100に対する位置精度が向上するため、パッケージ100の筒状部111と光ファイバ105のジャケット105bとの隙間を小さくして、パッケージ100の内部の気密性を向上させることができる。

【0055】(第1の実施形態の第2変形例)ところで、第1の実施形態に係る光通信用モジュールにおいては、光ファイバ105のピッグテールがパッケージ100から突出している。このため、光ファイバ105のピッグテールがパッケージ100から突出した状態で、光ファイバ105の入射部105aをベース102に固定する作業が必要になるので、生産性が損なわれたり、また、光通信用モジュールの占有面積が大きくなって量産性が損なわれる等の問題がある。

【0056】そこで、第2変形例においては、図6に示すように、ジャケット105bを有しない第1の光ファイバ105A(光通信用モジュールを構成する光ファイバ)におけるパッケージ100の筒状部111に挿入される部分に第1のフェルール131を固定すると共に、ジャケット105bを有する第2の光ファイバ105B(光伝送路を構成する光ファイバ)におけるジャケット105bが取り除かれた先端部に第2のフェルール132を固定し、第1のフェルール131と第2のフェルール132とを割スリーブ133によって固定している。

また、第2の光ファイバ105Bと第2のフェルール132とは筒状の連結部材134によって一体化されている。

【0057】このようにすると、第1の光ファイバ105Aの入射部105aをベース102に固定する際には、第1の光ファイバ105Aと第2の光ファイバ105Bとを分離しておくことができるため、生産性が向上すると共に、光通信用モジュールの占有面積が小さくなるので量産性も向上する。

【0058】また、第1の光ファイバ105Aに固定された第1のフェルール131と第2の光ファイバ105Bに固定された第2のフェルール132とは割スリーブ133によって一体化されているため、0.3dB以下の低い損失で第1の光ファイバ105Bとを接続することができる。

【0059】従って、第2変形例によると、光通信用モジュールの生産ラインの省スペース化が可能になると共に、光通信用モジュールのハンドリングが容易になるため生産ラインの自動化率を向上させることができる。

【0060】(第2の実施形態)以下、本発明の第2の 実施形態に係る光通信用モジュールについて図7を参照 しながら説明する。図7は光通信用モジュールの側方断 面図であるが、図7においては、パッケージ及びキャッ プは図示を省略している。

【0061】第2の実施形態に係る光通信用モジュールは、信号光を出力する光送信機能と信号光が入力される 光受信機能とを併せ持つ複合機能型の光通信用モジュールである。

【0062】第2の実施形態においても、第1の実施形 態と同様、ペルチェ素子201の上には方形板状の送信 用ベース202が設けられており、該送信用ベース20 2の上には半導体レーザ素子203及びモニター用受光 素子204が高精度に搭載されている。また、送信用べ ース202の上面には断面V字状の凹状溝が光軸方向に 延びるように形成されており、該凹状溝には単一モード の光ファイバ205が嵌め込まれている。送信用ベース 202の中央部の上側には、断面台形状の凹状溝を有す るファイバ押さえ部材206が固定されており、光ファ イバ205は送信用ベース202の凹状構の両壁面とフ ァイバ押さえ部材206の底面との3点によって狭持さ れている。さらに、送信用ベース202における半導体 レーザ素子203が搭載されている部分の右側には、光 軸と垂直な方向に延びる切欠き部207が形成されてお り、該切欠き部207の半導体レーザ素子203側の壁 面に光ファイバ205の左端面(入射端面)が当接して

【0063】第2の実施形態の特徴として、ペルチェ素子201の上には受信用ベース210が搭載されており、該受信用ベース210の中央部には光ファイバ205に対して所定角度を持つように光分岐器211が挿入

されている。光分岐器211は、半導体レーザ素子20 3から出射された後、光ファイバ205のコア部を左方 から右方に伝搬する出力信号光を通過させる一方、光ファイバ205の右端部から入射された後、光ファイバ2 05のコア部を右方から左方に伝搬する入力信号光を上 方に導く。受信用ベース210の上面における光分岐器 211の上側には、光分岐器211によって上方へ導か れた入力信号光を受光する受信用受光素子212が設け られている。

【0064】また、受信用ベース202における右側部分にはインライン型の小型アイソレータ213が挿入されており、光ファイバ205を伝搬する入力信号光が半導体レーザ素子203に進入することが防止されている。光ファイバ205の伝送経路にインライン型の小型アイソレータ213を挿入することは、半導体レーザ素子203として、外部から入射する光の影響を受けやすいDFBレーザ素子を用いる場合に特に有効である。

【0065】第2の実施形態においては、入力信号光の 波長、出力信号光の波長及び光分岐器211の種類を選択することによって、各種の用途に対応できる光通信用 モジュールを実現することができる。以下、光通信用モジュールの用途、入力信号光及び出力信号光の波長並び に光分岐器211の種類について説明する。

【0066】(1) 波長 $1.3\mu$ m帯の信号光を送信する送信機機能と、波長 $1.55\mu$ m帯の信号光を受信する受信機能とを併せ持つ光通信用モジュールの場合には、半導体レーザ素子203の発振波長を $1.3\mu$ m帯とし、受信用受光素子212の受信波長を $1.55\mu$ m帯とし、光分岐器212としては $1.3\mu$ m帯の光を通過させる一方、 $1.55\mu$ m帯の光を反射させるWDM型フィルター(多重伝送型フィルター)を用い、小型アイソレータ213としては半導体レーザ素子203から出射される光が外部に出射されるような透過方向を有しておればよい。また、受信用受光素子212としては、

1.  $55 \mu$  m帯の光を感じないパスパンド型であることが好ましい。

【0067】(2) 波長1.55 $\mu$ m帯の信号光を送信する送信機機能と、波長1.3 $\mu$ m帯の信号光を受信する受信機能とを併せ持つ光通信用モジュールの場合には、半導体レーザ素子203の発振波長を1.55 $\mu$ m帯とし、受信用受光素子212の受信波長を1.3 $\mu$ m帯とし、光分岐器212としては1.55 $\mu$ m帯の光を通過させる一方、1.3 $\mu$ m帯の光を反射させるWDM型フィルターを用い、小型アイソレータ213としては半導体レーザ素子203から出射される光が外部に出射されるような透過方向を有しておればよい。

【0068】(3) 波長1.  $3\mu$  m帯の信号光を送信する送信機機能と、波長1.  $3\mu$  m帯の信号光を受信する受信機能とを併せ持つ光通信用モジュールの場合には、半導体レーザ素子203の発振波長を1.  $3\mu$  m帯とし、

受信用受光素子 212の受信波長  $61.3\mu$  m帯とし、光分岐器 212としては  $1.3\mu$  m帯の光を所定割合だけ通過させ且つ所定割合だけ反射するハーフミラーを用い、小型アイソレータ 213としては半導体レーザ素子 203から出射される光が外部に出射されるような透過方向を有しておればよい。

【0069】(4) 波長 $1.55\mu$ m帯の信号光を送信する送信機機能と、波長 $1.55\mu$ m帯の信号光を受信する受信機能とを併せ持つ光通信用モジュールの場合には、半導体レーザ素子203の発振波長を $1.55\mu$ m帯とし、受信用受光素子212の受信波長も $1.55\mu$ m帯とし、光分岐器212としては $1.55\mu$ m帯とし、光分岐器212としては $1.55\mu$ m帯の光を所定割合だけ通過させ且つ所定割合だけ反射するハーフミラーを用い、小型アイソレータ213としては半導体レーザ素子203から出射される光が外部に出射されるような透過方向を有しておればよい。

【0070】(第3の実施形態)以下、本発明の第3の 実施形態に係る光通信用モジュールの検査方法について 図8〜図10を参照しながら説明する。図8は光通信用 モジュールの部分平面図、図9は検査方法を示す部分拡 大斜視図、図10は検査方法を示す全体斜視図である。 【0071】まず、第3の実施形態に係る検査方法が適 用される光通信用モジュールの平面構造について説明する。

【0072】第3の実施形態においても、第1の実施形態と同様、図示を省略したペルチェ素子の上に設けられた方形板状のベース302の上には半導体レーザ素子303及びモニター用受光素子304が高精度に搭載されている。また、ベース302の上面には断面V字状の凹状溝305が光軸方向に延びるように形成されており、該凹状溝305には図示しない単一モードの光ファイバが嵌め込まれる。ベース302における半導体レーザ素子303が搭載されている部分の右側には、光軸と垂直な方向に延びる切欠き部307が形成されており、該切欠き部307の半導体レーザ素子303側の壁面には図示しない単一モードの光ファイバの左端面が当接する。

【0073】ベース302の上面における切欠き部307よりも左側には、半導体レーザ素子303の下部電極に直接に接続された第1の外部電極308A、半導体レーザ素子303の上部電極に第1のボンディングワイヤ309により接続された第2の外部電極308B、モニター用受光素子304の下部電極に直接に接続された第3の外部電極308C及びモニター用受光素子304の上部電極に第1のボンディングワイヤ309により接続された第4の外部電極308Dがそれぞれ設けられている。

【0074】第3の実施形態の特徴として、ベース302の上面における切欠き部307よりも右側には、第1の外部電極308Aと第2のボンディングワイヤ311により接続された第1の検査用電極310A及び第2の

外部電極308Bと第2のボンディングワイヤ311により接続された第2の検査用電極310Bがそれぞれ設けられ、ベース302の上面における第3の外部電極308Cと第2のボンディングワイヤ311により接続された第3の検査用電極310Cが設けられ、ベース302の上面における第4の外部電極308Dの外側には該第4の外部電極308Dと第2のボンディングワイヤ311により接続された第4の検査用電極310Dが設けられている。

【0075】以下、第3の実施形態に係る光通信用モジュールの検査方法について図9及び図10を参照しながら説明する。

【0076】図9及び図10に示すように、検査用基板320にはベース302が挿入可能な大きさの位置決め用凹部321が形成されており、該位置決め用凹部321にはベース302が配置されている。尚、図10においては位置決め用凹部321は一次元的に形成されているが、位置決め用凹部321は二次元的に形成されていてもよい。

【0077】図示を省略した検査装置(スクリーニング 装置)の所定の位置に検査用基板320をセットした 後、スクリーニング用のフォトディテクタ322を該フ ォトディテクタ322の受光部322aが半導体レーザ 素子303の光軸と一致するように接近させる。次に、 半導体レーザ素子303に検査用電流を印加する駆動用 回路に接続された第1のプローブ針323A及び第2の プローブ針323Bを第1の検査用電極310A及び第 2の検査用電極310Bにそれぞれ接触させると共に、 モニター用受光素子304から出力されるモニター電流 を検出する検査用回路に接続された第3のプローブ針3 23C及び第4のプローブ針323Dを第3の検査用電 極310C及び第4の検査用電極310Dにそれぞれ接 触させる。次に、第1のプローブ針323A及び第2の プローブ針323Bから半導体レーザ素子303の下部 電極及び上部電極の間に検査用電流を印加した状態で、 第3のプローブ針323Cと第4のプローブ針324D との間に流れる電流を検出し、検出された電流に基づい て半導体レーザ素子303の電気的特性を検査する。こ のようにすると、光通信用モジュールの構造の複雑化を 招くことなく、半導体レーザ素子303の電気的特性を 検査することができる。

【0078】尚、第3の実施形態においては、半導体レーザ素子303から出射されるレーザ光の出力をモニター用受光素子304により検出したが、半導体レーザ素子303から出射されるレーザ光の出力をモニター用受光素子304及びフォトディテクタ322により検出してもよい。このようにすると、半導体レーザ素子303及びモニター用受光素子304の電気的特性を同時に検査することができる。

[0079]

【発明の効果】本発明の光通信用モジュールによると、 半導体レーザ素子に発生した熱はベースを介して冷却手 段に直接に伝わるので、放熱性が向上すると共に半導体 レーザ素子の温度を冷却手段によって直接に制御するこ とができる。また、ベースと半導体レーザ素子との間に 半導体レーザ素子を保持するレーザマウントが不要にな ると共に半導体レーザ素子から出射されたレーザ光を集 光する集光レンズが不要になるため、光通信用モジュー ルの低価格化及び小型化を図ることができる。

【0080】本発明の光通信用モジュールが、ベースに設けられ、光ファイバの他端部から入力された後、光ファイバ内を伝搬する入力信号光を上方へ導く光分岐器と、ベースの上に固定され、光分岐器により上方へ導かれた入力信号光を受ける受信用受光素子とを備えていると、光分岐器により上方へ導かれた入力信号光を受信用受光素子により受信できるので、双方向伝送システムに用いられる光通信用モジュールの小型化を図ることができる。

【0081】本発明の光通信用モジュールが、ベースに設けられ、光ファイバ内を伝搬する入力信号光が半導体レーザ素子に進入することを阻止するインライン型の光アイソレータを備えていると、光ファイバの他端部から入力された入力信号光は半導体レーザ素子に進入しない。従って、半導体レーザ素子として、外部から入射する光の影響を受けやすいDFBレーザ素子を用いることが可能になる。

【0082】本発明の光通信用モジュールが、ベースに設けられ、光ファイバの半導体レーザ素子に対する位置を規制する光ファイバ位置決め手段を備えていると、光ファイバの半導体レーザ素子に対する位置を光軸調整を行なうことなく機械的な精度のみで規制できるので、パッシブアライメント方式により光ファイバを実装することができる。

【0083】この場合、光ファイバ位置決め手段が、ベースに光軸方向へ延びるように形成され、光ファイバが 嵌合されることにより光ファイバの光軸と垂直な方向の 位置を規制する凹状溝と、ベースに光軸と垂直な方向へ 延びるように形成され、半導体レーザ素子側の壁面に光 ファイバの一端部が当接することにより光ファイバの光 軸方向の位置を規制する切り込み溝とを有していると、 半導体レーザ素子から出射されるレーザ光の光軸と光ファイバのコア部の中心軸とを一致させることが容易にな を共に半導体レーザ素子と光ファイバの一端部との距離を規制することができるので、パッシブアライメント 方式により実装された光ファイバの一端部における結合 効率を一層向上させることができる。

【0084】本発明の光通信用モジュールが、冷却手段に設けられ、ベースの冷却手段に対する位置を規制するベース位置決め手段を備えていると、ベースの冷却手段に対する位置を正確に規制することができる。

【0085】ベース位置決め手段が、冷却手段の上面に 形成され、ベースが嵌合可能な形状を有する凹部である と、ベースの冷却手段に対する位置を簡易且つ正確に規 制することができる。

【0086】また、ベース位置決め手段が、冷却手段の 上面に形成されたアライメントマークであると、画像認 識によってベースの冷却手段に対する位置を一層に規制 することができる。

【0087】本発明の光通信用モジュールにおいて、冷却手段がペルチェ素子であると、ベースの温度ひいては 半導体レーザ素子の温度を外部から容易且つ正確に制御 することができる。

【0088】本発明の光通信用モジュールにおいて、半導体レーザ素子が分布帰還型のレーザ素子であると、出力信号光の波長及び出力を広い温度範囲において安定させるさせることができ、半導体レーザ素子がポンプレーザであると、出力信号光の出力を増大することができ、半導体レーザ素子が狭放射角レーザ素子又はスポットサイズ変換レーザ素子であると、半導体レーザ素子から出射されるレーザ光を高い結合効率で光ファイバの一端部に結合させることができる。

【0089】本発明の光通信用レーザ素子において、光ファイバが、半導体レーザ素子のスポット径とほぼ等しいコア径を有する単一モードの光ファイバであると、半導体レーザ素子から出射されるレーザ光を高い結合効率で光ファイバの一端部に結合させることができる。

【0090】本発明の光通信用モジュールにおいて、半 導体レーザ素子がベースに鉛フリー半田によって固定さ れていると、製造工程における人体への悪影響を防止す ることができる。

【0091】本発明の光通信用モジュールにおいて、ベースは冷却手段に熱伝導性ペーストによって固定されていると、半導体レーザ素子に発生する熱をベースを介して冷却手段に効率良く放散することができる。

【0092】本発明の光通信用モジュールにおいて、ベースの下面に金属蒸着層が形成されていると、ベースと 冷却手段との間の熱交換効率が向上するので、半導体レーザ素子に発生する熱をベースを介して冷却手段に効率 良く放散することができる。本発明の光通信用モジュールが第1、第2、第3及び第4の検査用電極を備えていると、第1の検査用電極と第2の検査用電極との間に検査用電極との間に流れる電流を検出することにより、半導体レーザ素子の電気特性を容易に検査することができる。この場合、第1~第4の検査用電極はベースの上面に形成されているので、光通信用モジュールの小型化を妨げることなく、半導体レーザ素子の電気特性を検査することができる。

【0093】本発明の光通信用モジュールの検査方法によると、第1のプローブ針と第2のプローブ針との間に

検査用電流を印加することにより、半導体レーザ素子の下部電極と上部電極との間に検査用電流を印加することができると共に、第3のプローブ端子と第4のプローブ端子との間の電流を検出することにより、モニター用受光素子の下部電極と上部電極との間に流れる電流を検出することができるので、半導体レーザ素子の電気的特性を容易且つ確実に検査することができる。

【0094】本発明の光通信用モジュールの検査方法において、第1の検査用電極と第1の外部電極、第2の検査用電極と第2の外部電極、第3の検査用電極と第3の外部電極、及び第4の検査用電極と第4の外部電極とがそれぞれ電気的に接続されていると、第1及び第2の検査用電極と半導体レーザ素子の下部電極及び上部電極との電気的接続並びに第3及び第4の検査用電極とモニター用受光素子の下部電極及び上部電極との電気的接続を簡易に行なうことができるので、光通信用モジュールの小型化を妨げることなく、半導体レーザ素子の電気特性を検査することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態に係る光通信用モジュールを示す側方断面図である。

【図2】第1の実施形態に係る光通信用モジュールのキャップを取り除いた状態を示す平面図である。

【図3】第1の実施形態に係る光通信用モジュールを示す、図1におけるIII ーIII 線の断面図である。

【図4】第1の実施形態に係る光通信用モジュールを示す、図1におけるVI-VI線の断面図である。

【図5】第1の実施形態の第1変形例に係る光通信用モジュールの組立工程を示す斜視図である。

【図6】第1の実施形態の第2変形例に係る光通信用モジュールを示す側方断面図である。

【図7】第2の実施形態に係る光通信用モジュールを示す側方断面図である。

【図8】第3の実施形態に係る光通信用モジュールの検査方法を示す部分平面図である。

【図9】第3の実施形態に係る光通信用モジュールの検 査方法を示す部分拡大斜視図である。

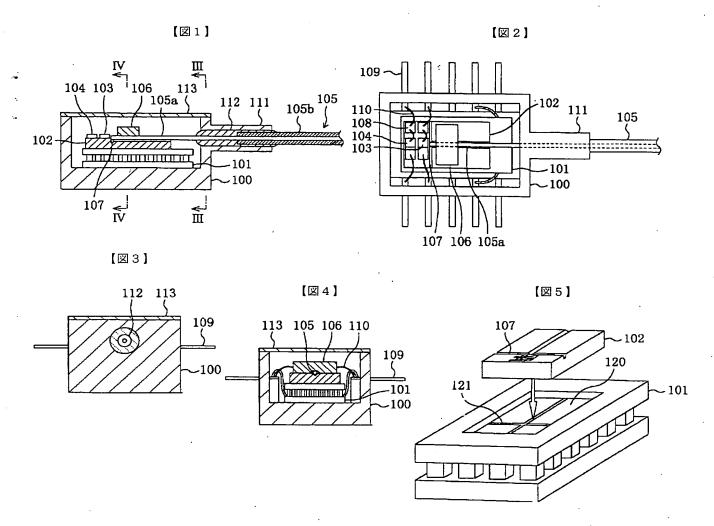
【図10】第3の実施形態に係る光通信用モジュールの 検査方法を示す全体斜視図である。

【図11】従来の光通信用モジュールを示す側方断面図である。

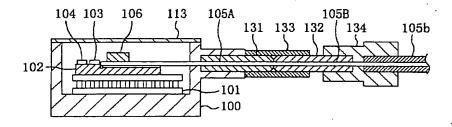
#### 【符号の説明】

- 100 パッケージ
- 101 ペルチェ素子
- 102 ベース
- 103 半導体レーザ素子
- 104 モニター用受光素子
- 105 光ファイバ
- . 105A 第1の光ファイバ
  - 105B 第2の光ファイバ

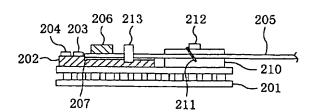
- 105a 入射部
- 105b ジャケット部
- 106 ファイバ押さえ部材
- 107 切欠き部
- 108 外部電極
- 109 外部リード
- 110 ボンディングワイヤ
- 111 筒状部
- 112 固定用樹脂
- 113 キャップ
- 120 位置決め用凹部
- 121 アライメントマーク
- 131 第1のフェルール
- 132 第2のフェルール
- 133 割スリーブ
- 134 連結部材
- 201 ペルチェ素子
- 202 送信用ベース
- 203 半導体レーザ素子
- 204 モニター用受光素子
- 205 光ファイバ
- 206 ファイバ押さえ部材
- 207 切欠き部
- 210 受信用ベース
- 211 光分岐器
- 212 受信用受光素子
- 213 小型アイソレータ
- 302 ベース
- 303 半導体レーザ素子
- 304 モニター用受光素子
- 305 凹状溝
- 307 切欠き部
- 308A 第1の外部電極
- 308B 第2の外部電極
- 308C 第3の外部電極
- 308D 第4の外部電極
- 309 第1のボンディングワイヤ
- 310A 第1の検査用電極
- 310B 第2の検査用電極
- 310C 第3の検査用電極
- 310D 第4の検査用電極
- 320 検査用基板
- 321 位置決め用凹部
- 322 フォトディテクタ
- 3 2 2 a 受光部
- 323A 第1のプローブ針
- 323B 第2のプローブ針
- 323C 第3のプローブ針
- 323D 第4のプローブ針



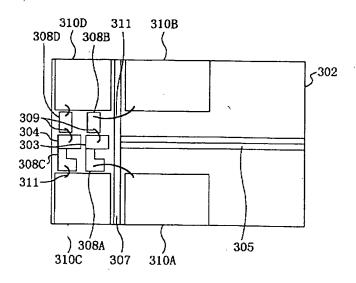
【図6】



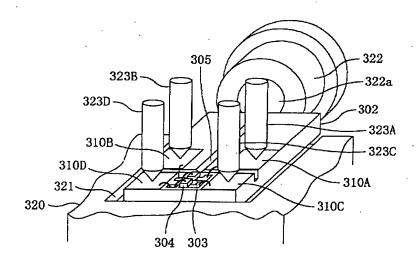
【図7】



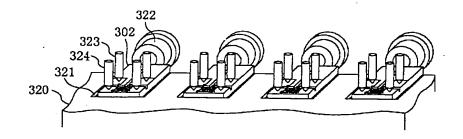
[図8]



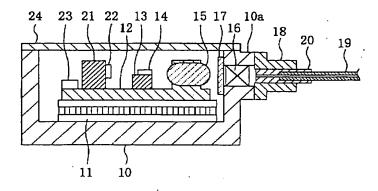
【図9】



[図10]



### 【図11】



#### フロントページの続き

#### (72)発明者 松田 賢一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

This Page Blank (uspto)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| ☐ BLACK BORDERS   |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                                 |
| ( FADED TEXT OR DRAWING   |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                                  |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES   |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                                  |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS  |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                                   |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY                 |
| OTHER:  |

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (USDIO)